

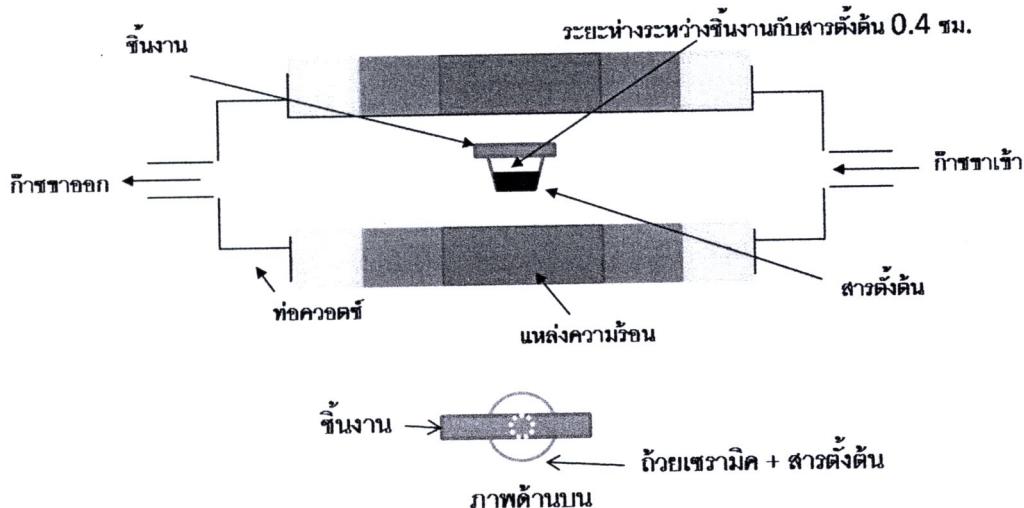
## บทที่ 4

### ผลการทดลอง

ผลการทดลองที่จะรายงานในบทนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 4.1) รายงานผล ของการเปลี่ยนแปลงสารตั้งต้น , 4.2) รายงานผลของตำแหน่งของแผ่นฐานในเตาปฏิกรณ์ , 4.3) รายงานผลของการเปลี่ยนแปลงก้าวปฏิกรณ์ และ 4.4) รายงานผลผลกระทบจากสารตั้งต้นที่ถูกปนเปื้อนด้วย Cu

#### 4.1 ผลของการเปลี่ยนแปลงสารตั้งต้น

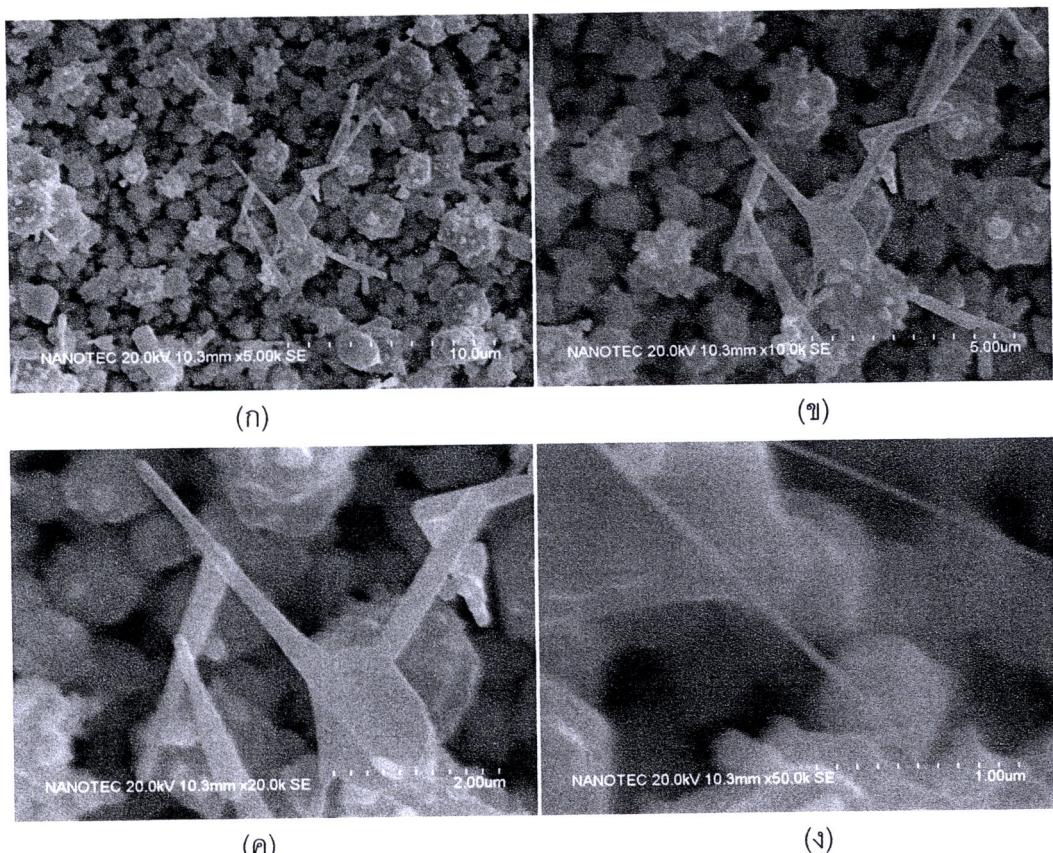
สารตั้งต้นเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างของ ZnO ที่สังเคราะห์โดยกระบวนการขันถ่ายไฟฟ้า สารตั้งต้นที่ใช้สังเคราะห์ ZnO ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้แก่ ก) ผง ZnO บริสุทธิ์ และ ข) ผง ZnO บริสุทธิ์และ CNT ผสมกันในอัตราส่วน โมล 1: 1 น้ำหนัก 0.5 กรัม โดยขั้นตอนการสังเคราะห์ได้อธิบายไปในหัวข้อที่ 3.1 หัวข้อนี้จะรายงานผลการตรวจวัดสมบัติทางกายภาพโดยเทคนิค SEM และอธิบายปฏิกรณ์เคมีที่เกิดขึ้น



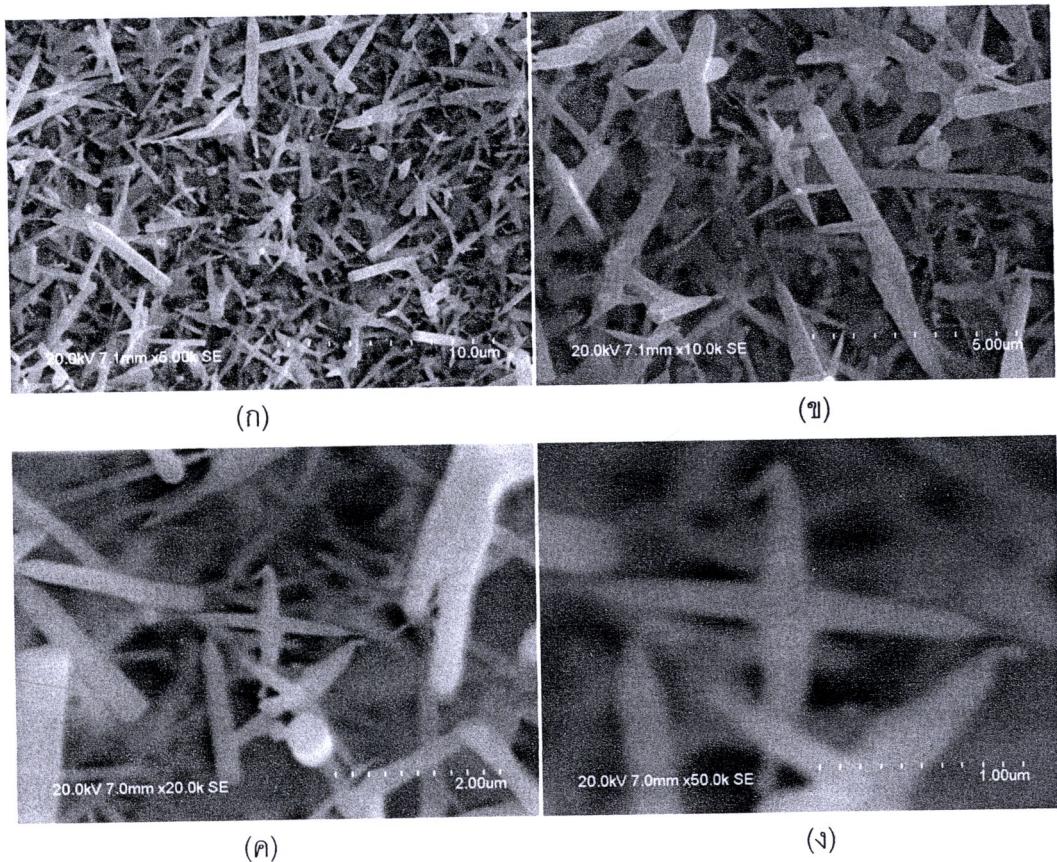
รูปที่ 4.1: รูปตัดขวางของเตาปฏิกรณ์ที่ใช้สังเคราะห์

#### 4.1.1 ผลการตรวจวัดโครงสร้างโดยเทคนิค SEM

เมื่อสารตั้งต้น ZnO เพียงอย่างเดียว โครงสร้างที่สังเคราะห์ได้จะเป็นดังแสดงในรูปที่ 4.2 โครงสร้างส่วนใหญ่ที่สังเกตได้คือ กลุ่มก้อนขนาด 1-3  $\mu\text{m}$  โดยมี nanorods และ nanoneedles ความยาว 2-3  $\mu\text{m}$  ปะปนอยู่บ้างเล็กน้อย แต่ เมื่อเปลี่ยนสารตั้งต้นเป็นสารผสม ZnO/CNTs โครงสร้างที่ปรากฏมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 4.3 คือ tetrapods มีขนาด 2-4  $\mu\text{m}$  โดย nanorods ความยาว 2-5  $\mu\text{m}$  และ nanoneedles ปะปนอยู่เล็กน้อย

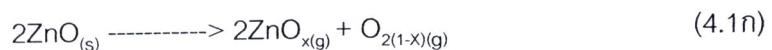


รูปที่ 4.2: ภาพ SEM ของ ZnO ที่สังเคราะห์โดยใช้ ZnO ขนาดขยาย (ก) 5,000, (ข) 10,000, (ค) 20,000 และ (จ) 50,000 เท่า

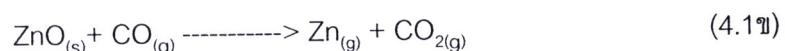


รูปที่ 4.3: ภาพ SEM ของ ZnO ที่สังเคราะห์โดยใช้ ZnO/CNTs ขนาดขยาย (ก) 5,000, (ข) 10,000, (ค) 20,000 และ (ง) 50,000 เท่า

ในการสังเคราะห์โครงสร้างนาโน  $ZnO$  โดยใช้สารตั้งต้น เพียงชนิดเดียวคือ  $ZnO$  จะมีปฏิกิริยาตั้งตันคือ

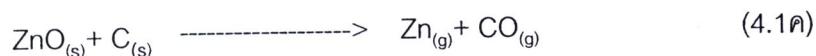


กล่าวคือ สารตั้งต้น  $ZnO$  สามารถสูญเสียออกซิเจนได้บางส่วน เกิดเป็น  $ZnO_x$  ( $x < 1$ ) ซึ่งมีจุดหลอมเหลวต่ำ ( $419^\circ C$ ) เมื่อปัลอยก้าชปฎิกิริยาเข้ามา  $CO$  ในบรรยากาศสามารถทำปฏิกิริยากับ  $ZnO$  ได้เป็น  $Zn$  ดังปฏิกิริยา



จากนั้นผ่านก๊าซปฏิกิริยาเข้าสู่ระบบซึ่งเป็นก๊าซจากสภาพแวดล้อมมีออกซิเจนเป็นส่วน ประกอบกับการออกซิเดชันเป็น  $ZnO$  ในลำดับต่อไป

เมื่อสารตั้งต้นเปลี่ยนเป็นสารผสม  $ZnO/CNTs$  ปฏิกิริยาทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ในเตาปฏิกิริณ์จะเป็นดังสมการ (4.1ค)-(4.1ช) เมื่ออุณหภูมิภายนอกลดลงจาก  $OnZ/sTNC$  สามารถเกิดปฏิกิริยาเร็วตักขัน ระหว่างสารผสมของ ดังสมการ (4.1ค) และ  $CO$  ที่ได้สามารถเกิดปฏิกิริยาเร็วตักขันกับ  $ZnO$  เกิดเป็น  $Zn$  และ  $ZnO_x$  ดังสมการ (4.1ง) และ (4.1จ) ตามลำดับ ซึ่ง  $CNTs$  สามารถเกิดปฏิกิริยาข้ามกับ  $CO_2$  เกิดเป็น  $CO$  ดังสมการ (4.1น) ในขณะที่สารตั้งต้น  $ZnO$  สามารถสูญเสียออกซิเจนได้บางส่วนเกิดเป็น  $ZnO_x$  เช่นเดียวกับ สมการ (4.1ก) เช่นเดียวกัน สุดท้ายปฏิกิริยา (4.1ง) และ (4.1ช) จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ปล่อยก๊าซปฏิกิริยาเข้ามา [63-65]



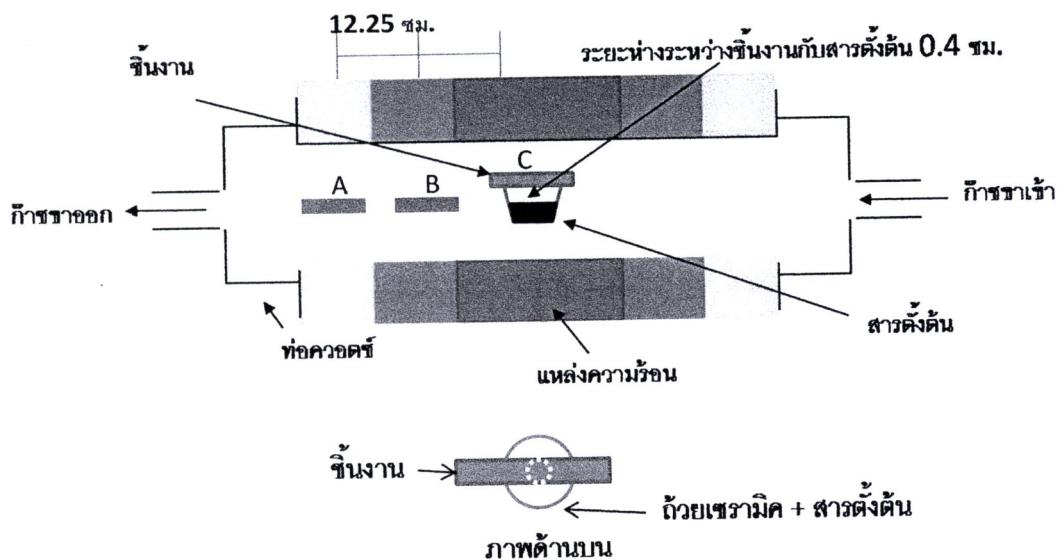
จากนั้นผ่านก๊าซปฏิกิริยาเข้าสู่ระบบซึ่งเป็นก๊าซจากสภาพแวดล้อมมีออกซิเจนเป็นส่วนประกอบ กับการออกซิเดชันเป็น  $ZnO$  ในลำดับต่อไป

โครงสร้างนาโน  $ZnO$  เกิดจากกลไก vapor-solid (VS) ไอระเหยของ  $Zn$  และ  $ZnO_x$  ก่อตัวขึ้นเป็นนิวเคลียสจากนั้นไอระเหยของ  $Zn$  และ  $ZnO_x$  จะเริ่มจับตัวกันเกิดเป็นโครงสร้างนาโน  $ZnO$  ที่แตกต่างกันไป ลักษณะโครงสร้าง  $ZnO$  ที่ได้จะขึ้นกับปัจจัยของนิวเคลียสที่ก่อตัวขึ้นในช่วงแรก [54,66]

ข้อแตกต่างระหว่างเงื่อนไขการทดลอง ทั้งสองคือปริมาณของ  $Zn$  และ  $ZnO_x$  ที่เกิดขึ้นในการทดลองที่ใช้  $ZnO$  เป็นสารตั้งต้นเพียงอย่างเดียว จะให้  $Zn$  และ  $ZnO_x$  น้อยกว่าการทดลองที่ใช้  $ZnO/CNTs$  หาก เนื่องจากขาด  $C$  ซึ่งเปรียบเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยาในการเกิด  $Zn$  และ  $ZnO_x$  เพื่อการก่อตัวเป็นนิวเคลียสและโครงสร้างนาโน  $ZnO$  ในลำดับต่อไป

#### 4.2 ผลของการดำเนินการของแผ่นฐานในเตาปฏิกรณ์

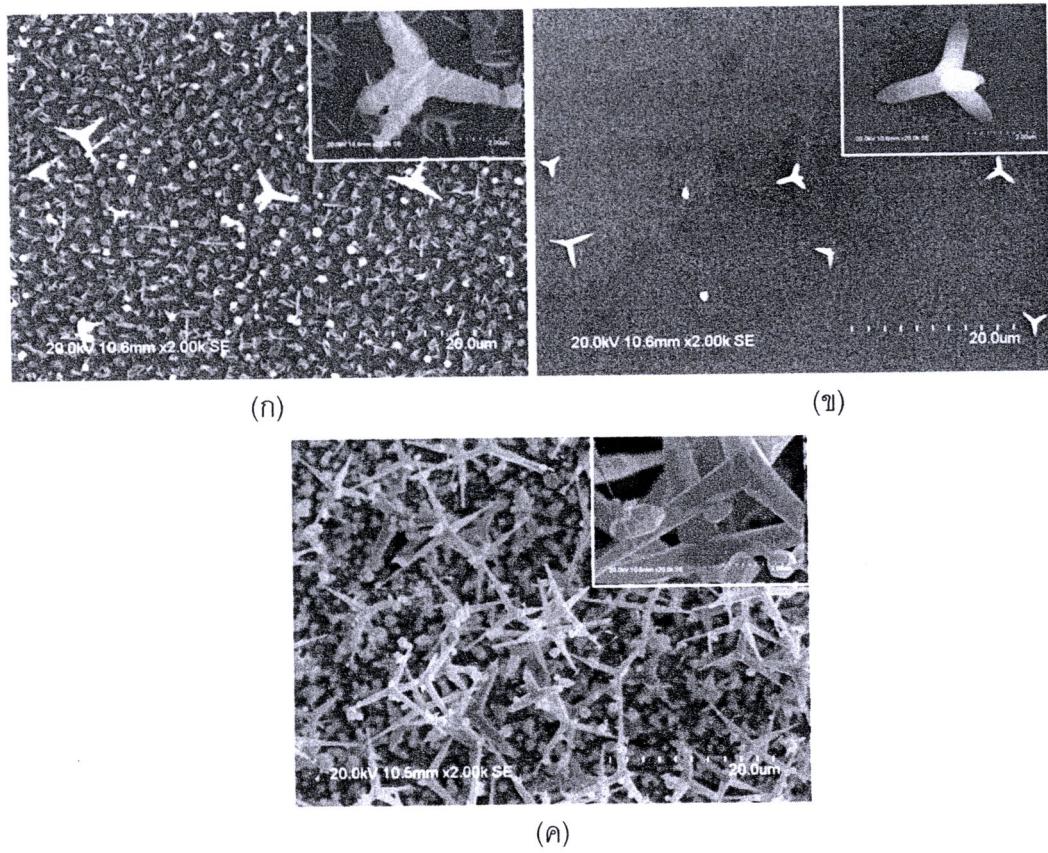
ดำเนินการของแผ่นฐานในเตาปฏิกรณ์มีผลกระทบต่อปริมาณและสัณฐานของ ZnO ที่สังเคราะห์ได้ หัวข้อนี้รายงานผลการสังเคราะห์โครงสร้าง nano ใน ZnO เมื่อแผ่นฐานถูกวางไว้บนเตาปฏิกรณ์ต่างๆ ในเตาปฏิกรณ์ดังแสดงในรูปที่ 4.4 แผ่นฐาน A, B และ C ในรูปถูกวางห่างกันเป็นระยะ 12.25 cm โดยแผ่นฐาน A อยู่ที่ปลายของท่อความดัน, C อยู่ที่กลางท่อความดัน และ B อยู่กึ่งกลางระหว่าง A และ C อุณหภูมิและปริมาณสารตั้งต้นที่กลางท่อจะสูงที่สุด ตั้งนั้นอุณหภูมิของแผ่นฐานและปริมาณของการสารตั้งต้นสำหรับแผ่นฐาน C จะสูงกว่าแผ่นฐาน B ซึ่งจะสูงกว่าแผ่นฐาน A อีกต่อหนึ่ง ZnO ที่ก่อตัวบนแผ่นฐานทั้งสามถูกนำมาวิเคราะห์โดยเทคนิค SEM, XRD และ EDX โดยมีผลตามลำดับดังนี้



รูปที่ 4.4: การสังเคราะห์โดยวางแผ่นฐานที่ตำแหน่ง A, B และ C

#### 4.2.1 ผลการตรวจวัดโครงสร้างโดยเทคนิค SEM

ในการเตรียมโครงสร้างนาโน ZnO โดยกระบวนการขันถ่ายเพลสไอ ขนาดและปริมาณของโครงสร้างนาโน ZnO จะขึ้นกับปริมาณไออกไซด์ของสารตั้งต้น อุณหภูมิของสารตั้งต้น และตำแหน่งของแผ่นฐาน ผลที่ได้จากขั้นตอนพัฒนาจึงแตกต่างกันไปดังรูปที่ 4.5 ตำแหน่ง A มีปริมาณ ZnO น้อยที่สุด ตำแหน่ง B มีปริมาณน้อย และตำแหน่ง C มีปริมาณมากที่สุด โดยทุกตำแหน่งสามารถพบร่องรอยของ ZnO ซึ่งวัดจากปลายด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งจะเพิ่มขึ้นจาก 4  $\mu\text{m}$  ในแผ่นฐาน A ไปเป็น 10  $\mu\text{m}$  ในแผ่นฐาน C ในขณะที่ความยาวของแต่ละขาของ tetrapod จะเพิ่มขึ้นจาก 2  $\mu\text{m}$  ในแผ่นฐาน A ไปเป็น 5  $\mu\text{m}$  ในแผ่นฐาน C



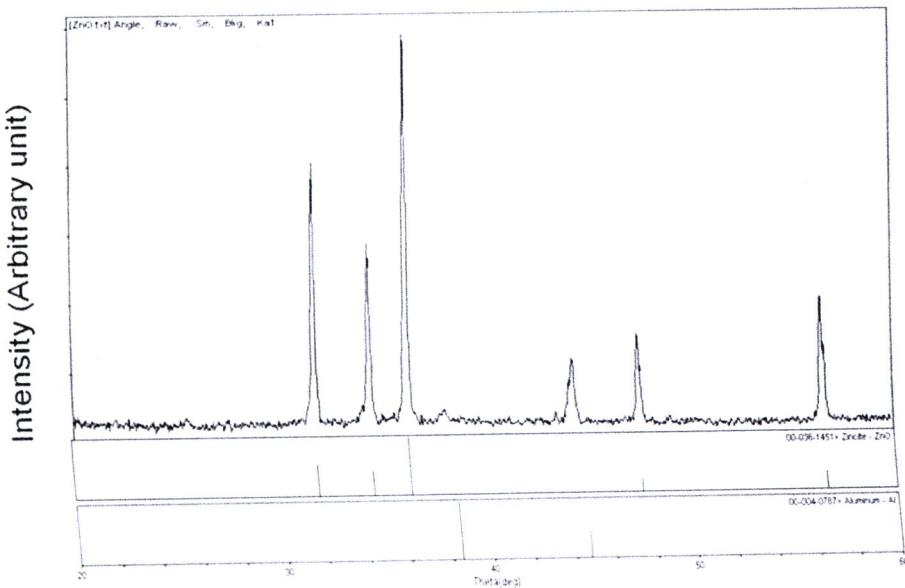
รูปที่ 4.5: ภาพ SEM ขนาดขยาย 2,000 เท่า (รูปใหญ่) และ 20,000 เท่า (รูปขยาย) ของ ZnO ที่ก่อตัวบนแผ่นฐาน (a) A, (b) B และ (c) C

อุณหภูมิ ของสารตั้งต้น และแผ่นฐานในแต่ละตำแหน่ง มีความแตกต่าง กัน เนื่องจาก บริเวณปลายท่อสัมผัสกับสภาพแวดล้อมโดยตรง ก่อให้เกิดการก่อตัวที่อุณหภูมิต่ำ สังเกตได้จากที่ ตำแหน่ง A พบโครงสร้าง T-ZnO ที่มีพื้นผิวเรียบ ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กอยู่รอบๆ พิจารณาได้ว่าเกิดจากการ ก่อตัวก้อนอย่างไม่สมบูรณ์ ของ ZnO<sub>x</sub> ซึ่งมีจุดหลอมเหลวต่ำ (419°C) เนื่องจากบริเวณนี้อยู่ใกล้กับสภาพแวดล้อมมากที่สุดทำให้อุณหภูมิที่แท้จริงต่ำกว่าอุณหภูมิที่ตรง กลางท่อ เมื่อมีการสังเคราะห์จะเกิด ZnO<sub>x</sub> เกาะอยู่บริเวณของปลายท่อโดยรอบ , ตำแหน่ง B พบ โครงสร้างของ T-ZnO โดยแทนไม่พบโครงสร้างอื่นปะปนมาด้วย และ ตำแหน่ง C พบความ หลากหลายของโครงสร้าง nano ใน ZnO มากที่สุดคือ nanorods, nanopencils, nanoneedles และ T-ZnO สังเกตได้ว่ามี nanoneedles ยื่นออกมาจาก nanopencils โดยขนาดของ nanoneedles และ nanopencils มีขนาด 1 μm และ 1-2 μm ตามลำดับ

การเตรียมโครงสร้าง nano ใน ZnO ด้วยสารตั้งต้น ZnO/CNTs ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นสมการ อธิบายได้ด้วยสมการ (4.1ค) ถึง (4.1ช) จากการทดลอง 4.1 ผลที่ได้คือไอระเหย Zn และ ZnO<sub>x</sub> ซึ่ง เป็นส่วนสำคัญในการเกิดโครงสร้าง nano ใน ZnO ตำแหน่งของ แผ่นฐานมีผลต่อปริมาณไอระเหย ของ Zn และ ZnO<sub>x</sub> เมื่อระย่างระหว่างแผ่นฐานและสารตั้งต้นเพิ่มมากขึ้น โอกาสที่ไอระเหยจะ เกิดติดบนแผ่นฐานมีค่าลดลง ส่งผลให้ปริมาณโครงสร้าง nano ใน ZnO ที่ปรากฏบนแผ่นฐาน A มี ค่าน้อยที่สุด, B มีค่าน้อย และ C มีค่ามากที่สุด

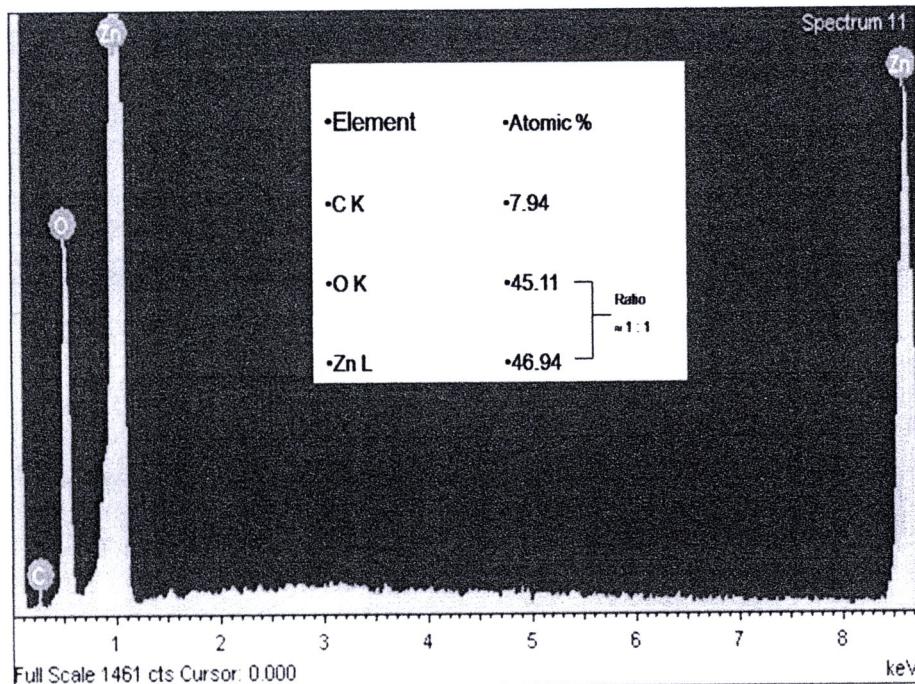
ลักษณะของโครงสร้างที่ปรากฏ จะขึ้นกับปริมาณของไอระเหย Zn และ ZnO<sub>x</sub> ที่ก่อตัวเป็น นาโนเคลือส รูปแบบต่างๆ [54,66] ในบรรดารูปแบบทั้งหมด อาจกล่าวได้ว่านาโนเคลือส สามารถก่อ ตัวเป็น T-ZnO สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดเนื่องจาก พบได้ในทุกตำแหน่งของการทดลองนี้ [32] ตำแหน่ง C โครงสร้างหลากหลายที่สุด ปริมาณไอระเหย Zn และ ZnO<sub>x</sub> มากที่สุด [67-68]

#### 4.2.2 ผลการตรวจวัดโครงสร้างโดยเทคนิค XRD และ EDX



รูปที่ 4.6: สเปกตรัมการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์จากชิ้นงาน C เทียบกับฐานข้อมูลสเปกตรัมของ Hexagonal wurtzite ZnO และ Al

ชิ้นงาน C มีปริมาณ ZnO หนาแน่นที่สุดจึงถูกนำมาตรวจวัดเพื่อหาองค์ประกอบทางเคมี โดยเทคนิค XRD และ EDX ส่วนชิ้นงาน A และ B นั้นมีปริมาณของ ZnO น้อยเกินกว่าที่จะตรวจวัดได้ ผลการวัดสเปกตรัมการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของชิ้นงาน C ถูกแสดงในรูปที่ 4.6 ซึ่งแสดงมุมเลี้ยวเบนที่  $31.9^\circ$ ,  $34.2^\circ$ ,  $36.0^\circ$ ,  $44.5^\circ$ ,  $47.5^\circ$  และ  $56.5^\circ$  เมื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล JCPDS no. 36-1451 จะพบว่ามุมเลี้ยวเบนแทบทั้งหมดสอดคล้องกับโครงสร้าง ZnO ที่แลดทิชเรียงตัวแบบ Hexagonal Wurtzite มีเพียงมุมเดียวที่  $44.5^\circ$  ที่อาจเกิดจากแทนわりชิ้นงานที่เป็นอะลูมิเนียม JCPDS no. 4-0787



รูปที่ 4.7: สเปกตรัมองค์ประกอบทางเคมีจากชิ้นงาน C

ผลการวัดสเปกตรัม EDX ของชิ้นงานเดียวกันถูกแสดงในรูปที่ 4.7 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าสัดส่วนโมลของอะตอม Zn (46.94%) ต่อ O (45.11%) มีค่าประมาณ 1: 1 แสดงถึงการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง Zn กับ O ที่สมบูรณ์เนื่องจากมีอัตราส่วนปริมาณสารสัมพันธ์ (stoichiometric ratio) ที่ใกล้กับอุดมคติ สัดส่วนของ C (7.94%) ในชิ้นงานแสดงว่า CNTs จากสารตั้งต้น ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างคงหลังเหลืออยู่ใน ZnO ที่สังเคราะห์ได้

ผลการทดลอง XRD และ EDX ข้างต้นสอดคล้องกันในผลของ ZnO ที่วัดได้แต่ต่างกันในผลของสารปูนเปื้อน สาเหตุมาจากการที่ เทคนิค EDX สามารถเห็นภาพกำลังขยาย ขณะวัด การเลือกตัวแหน่งในการวัด จึงทำได้อย่างแม่นยำ สัญญาณที่พบจึงเกิดจากโครงสร้างนาโนเท่านั้น ไม่พบอะลูมิเนียมจากแท่นวางชิ้นงาน แต่อย่างใด แต่เทคนิค XRD ไม่สามารถเห็นภาพกำลังขยาย ขณะวัดได้ความแม่นยำในการเลือกตัวแหน่งในการวัดจึงขึ้นกับผู้เตรียมชิ้นงาน ความคลาดเคลื่อน ของตัวแหน่งจึงเกิดขึ้นได้ทำให้พบค่ายอดของอะลูมิเนียมที่เกิดจากแท่นวางชิ้นงานและค่ายอดของ C ที่มีปริมาณน้อยจึงไม่สามารถตรวจพบได้

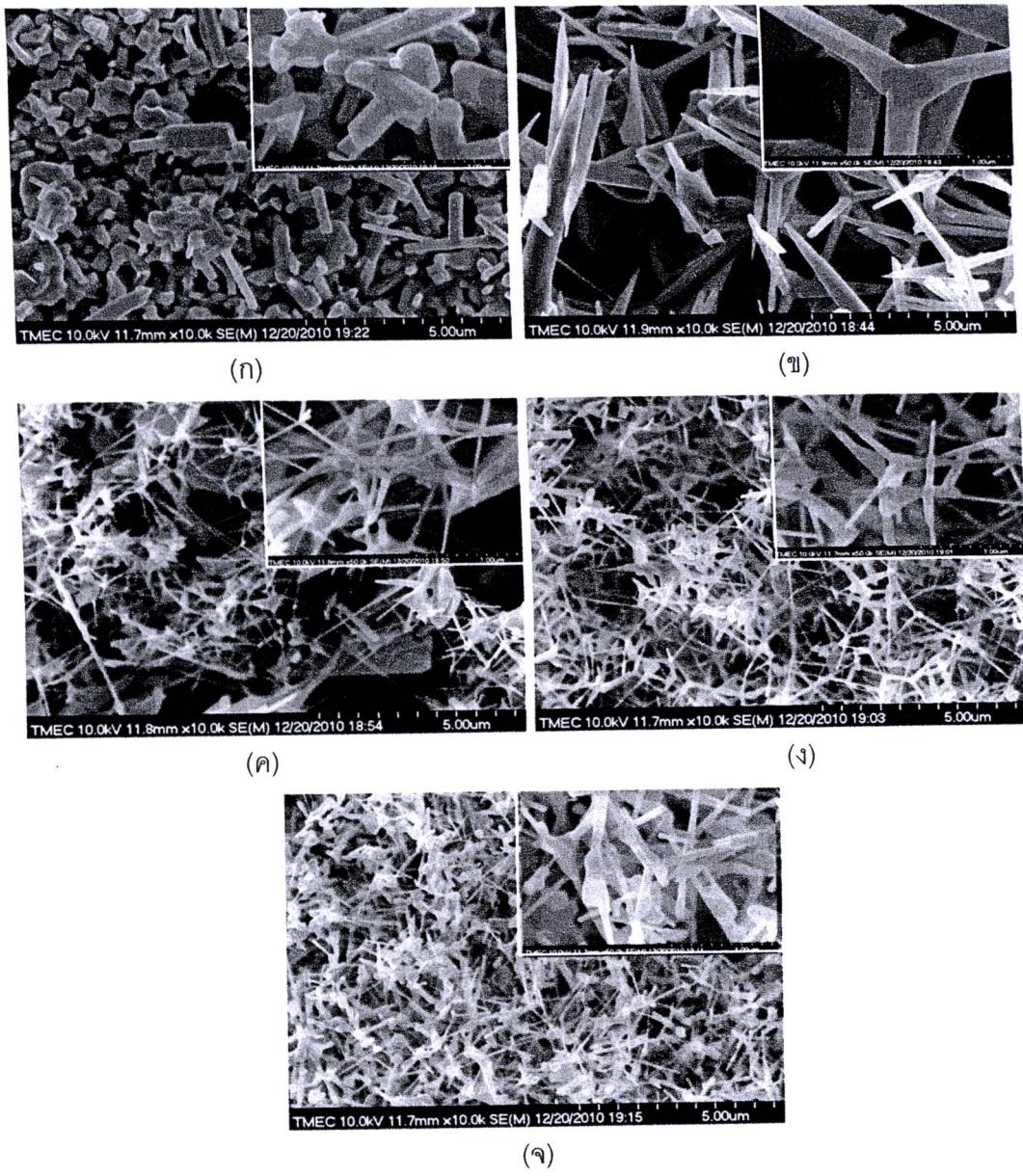
### 4.3 ผลของการเปลี่ยนแปลงก้าซปฏิกิริยา

ก้าซปฏิกิริยาที่ปล่อยเข้ามายังขั้นตอนสุดท้ายมีผลกระทบต่อโครงสร้าง nano  $ZnO$  ที่สังเคราะห์ได้ หัวข้อนี้รายงานผลการสังเคราะห์โครงสร้าง nano ใน  $ZnO$  เมื่อก้าซปฏิกิริยา เป็นออกซิเจน, Air Zero, Air Zero ที่ผ่านน้ำอุณหภูมิ  $35^{\circ}C$ ,  $45^{\circ}C$  และ  $55^{\circ}C$  ดังสรุปในตารางที่ 4.1 ก้าซปฏิกิริยา Air Zero ประกอบด้วยก้าซ nano 78 %, ก้าซออกซิเจน 21 % และที่เหลือต่ำกว่า 1 % ประกอบด้วยก้าซเนื้อยต่างๆ เช่น He, Ne, Ar, Kr, Xe โดยปราศจากการชีนและสารจำพวกไฮโดรคาร์บอน  $ZnO$  ที่สังเคราะห์ได้จากก้าซปฏิกิริยาทั้ง 5 เนื่องจากถูกนำไปวิเคราะห์โดยเทคนิค SEM, XRD, EDX, PL และลักษณะสมบัติกระแทก-แรงดัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางที่ 4.1: เนื่องจากการทดลองสำหรับหัวข้อที่ 4.3

การทดลอง เนื่องจาก	ก้าซปฏิกิริยา
4.3.1	ก้าซออกซิเจน
4.3.2	Air Zero
4.3.3	Air Zero + น้ำอุณหภูมิ $35^{\circ}C$
4.3.4	Air Zero + น้ำอุณหภูมิ $45^{\circ}C$
4.3.5	Air Zero + น้ำอุณหภูมิ $55^{\circ}C$

#### 4.3.1 ผลการตรวจวัดโครงสร้างโดยเทคนิค SEM



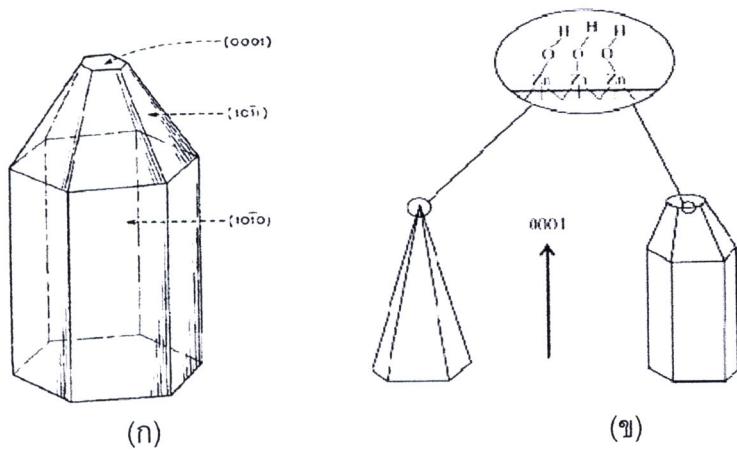
รูปที่ 4.8: ภาพ SEM ขนาดขยาย 10,000 เท่า (รูปใหญ่) และ 50,000 เท่า (รูปขยาย) ของ ZnO ที่เกิดจากก้าซปฏิกิริยา (ก) ออกซิเจน, (ข) Air Zero, Air Zero ผ่านน้ำอุณหภูมิ (ค) 35°C, (จ) 45°C และ (จ) 55°C

ในการเตรียมโครงสร้างนาโน ZnO ที่เตรียมโดยกระบวนการขันถ่ายเฟสไอโดยใช้สารผสม ZnO/CNTs ลักษณะโครงสร้างนาโน ZnO จะขึ้นกับชนิดของก้าซปฏิกิริยาที่เข้าไปทำปฏิกิริยากับนิวเคลียล์ที่ก่อตัวเป็นกฎร่วงต่างๆ จาก Zn และ  $ZnO_x$  ที่ได้จากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก่อนจะปล่อยก้าซ

ปฏิกิริยาเข้ามาระหว่างสารผสม ZnO/CNTs ดังแสดงในการทดลองที่ 4.1 และ 4.2 เมื่อปริมาณของออกซิเจนสูงที่สุดคือก๊าซ ปฏิกิริยาออกซิเจน โครงสร้างที่สังเกตได้มีลักษณะหล่อล็อกต์แต่แกนกลางจนถึงปลายและโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่อยู่โดยรอบ ดังแสดงในรูปที่ 4.8(ก) จนกระทั้งลดปริมาณของออกซิเจนลงเป็นก๊าซปฏิกิริยา Air Zero โครงสร้างที่สังเกตได้มีลักษณะแห้งเรียบแหลมดังแสดงในรูปที่ 4.8(ข) จากนั้นเพิ่มผลของความชื้นเป็นก๊าซปฏิกิริยา Air Zero ผ่านน้ำอุณหภูมิ 35°C โครงสร้างที่สังเกตได้มีลักษณะเรียบแหลม ขนาดเล็กและยังสามารถสังเกตโครงสร้างขนาดใหญ่อยู่ลึกลงไปดังแสดงในรูปที่ 4.8(ค) สุดท้ายเมื่อเพิ่มปริมาณความชื้นเป็นก๊าซปฏิกิริยา Air Zero ผ่านน้ำอุณหภูมิ 45°C และ 55°C โครงสร้างที่สังเกตได้โดยรวมมีขนาดเล็ก เช่นเดียวกันแต่มีปริมาณโครงสร้างขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้นดังแสดงในรูปที่ 4.8(ง)-4.8(จ) ตามลำดับ

ปริมาณของออกซิเจนที่เข้าไปทำปฏิกิริยาเป็นตัวแปรสำคัญต่อลักษณะโครงสร้างนาโน ZnO เมื่อมีปริมาณออกซิเจนสูงจะสามารถเกิดการออกซิเดชันที่สมบูรณ์กับ Zn หรือ  $ZnO_x$  ได้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับก๊าซปฏิกิริยาอื่นๆ โครงสร้างที่สังเกตได้จะมีลักษณะหล่อล็อกต์โดยผลึกที่สมบูรณ์ของ ZnO (Hexagonal Wurtzite) จนกระทั้งลดปริมาณออกซิเจนลง (ก๊าซปฏิกิริยา Air Zero) โครงสร้างที่สังเกตได้มีลักษณะปลายเรียบแหลม [32]

ผลของความชื้นที่เข้าไปทำปฏิกิริยาส่งผลให้โครงสร้างที่สังเกตได้มีลักษณะเส้นสายหรือแห้งขนาดเล็กซึ่งกลไกการก่อตัวสามารถอธิบายโดยใช้แบบจำลองของ Laudise [69] ดังนี้ โครงสร้างนาโน ZnO เกิดจากอะตอมของ Zn และ O สร้างพันธะขึ้นเป็นทรงสี่เหลี่ยมมีการจัดเรียงตัวของอะตอมในแลตทิซแบบ Hexagonal close-packed เกิดแบบชั้นต่อชั้น (layer by layer) เมื่อมีโมเลกุลของ OH ก่อตัวขึ้นเกิดเป็นระนาบ [10-11] รอบศูนย์กลางดังแสดงในรูปที่ 4.9 และระนาบ [0001] ซึ่งเป็นระนาบที่ไม่เสถียรส่งผลให้โครงสร้างนาโน ZnO ที่ได้มีความเร็วในการเกิด (growth velocities) ของ  $V_{[0001]} > V_{[10-11]} > V_{[10-10]}$  เกิดเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเรียบและแหลม จนกระทั้งเพิ่มอุณหภูมิสูงเปรียบเสมือนการเพิ่มปริมาณ OH ส่งผลให้โครงสร้างนาโน ZnO บนผิวน้ำแข็งแผ่นฐานเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลอง [52,70-72] และงานวิจัยนี้



รูปที่ 4.9: กลไกการเกิดโครงสร้างนาโนใน ZnO ที่มีผลของ O-H (η) [52] และ (Ξ) [69]

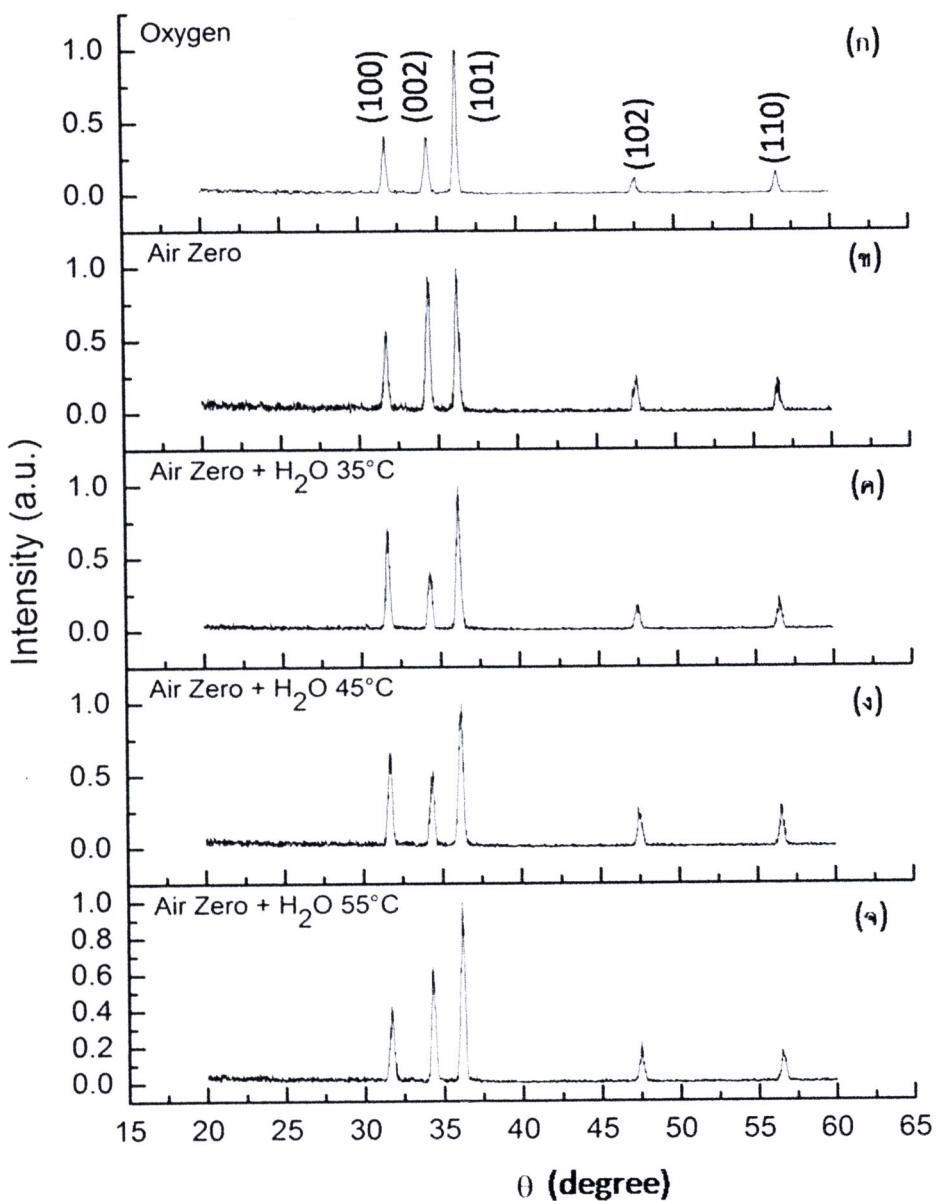
#### 4.3.2 ผลการตรวจวัดโครงสร้างโดยเทคนิค XRD และ EDX

ผลการวัดสเปกตรัมการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์โดยเทคนิค XRD ของชิ้นงานหั้ง 5 ถูกแสดงในรูปที่ 4.10 ซึ่งแสดงมุมเลี้ยวเบนที่  $31.9^\circ$ ,  $34.2^\circ$ ,  $36.0^\circ$ ,  $47.5^\circ$  และ  $56.5^\circ$  เมื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล JCPDS no. 36-1451 พบร่วมกันว่า มุมเลี้ยวเบนทั้งหมดสอดคล้องกับโครงสร้าง ZnO ที่แลดที่เรียงตัวแบบ Hexagonal Wurtzite ความเข้มของค่ายอดที่เกิดขึ้นในแต่ละระนาบที่แตกต่างกันสามารถอธิบายได้ดังนี้ 1) การจัดเรียงตัวในแต่ละระนาบของโครงสร้างผลึก (crystallographic orientation), 2) ความไม่เป็นหนึ่งเดียว (non-uniform) ของโครงผลึกที่เกิดขึ้นบนแผ่นฐาน และ 3) ตำแหน่งของรังสีเอ็กซ์ที่ตอกกระแทบชิ้นงาน

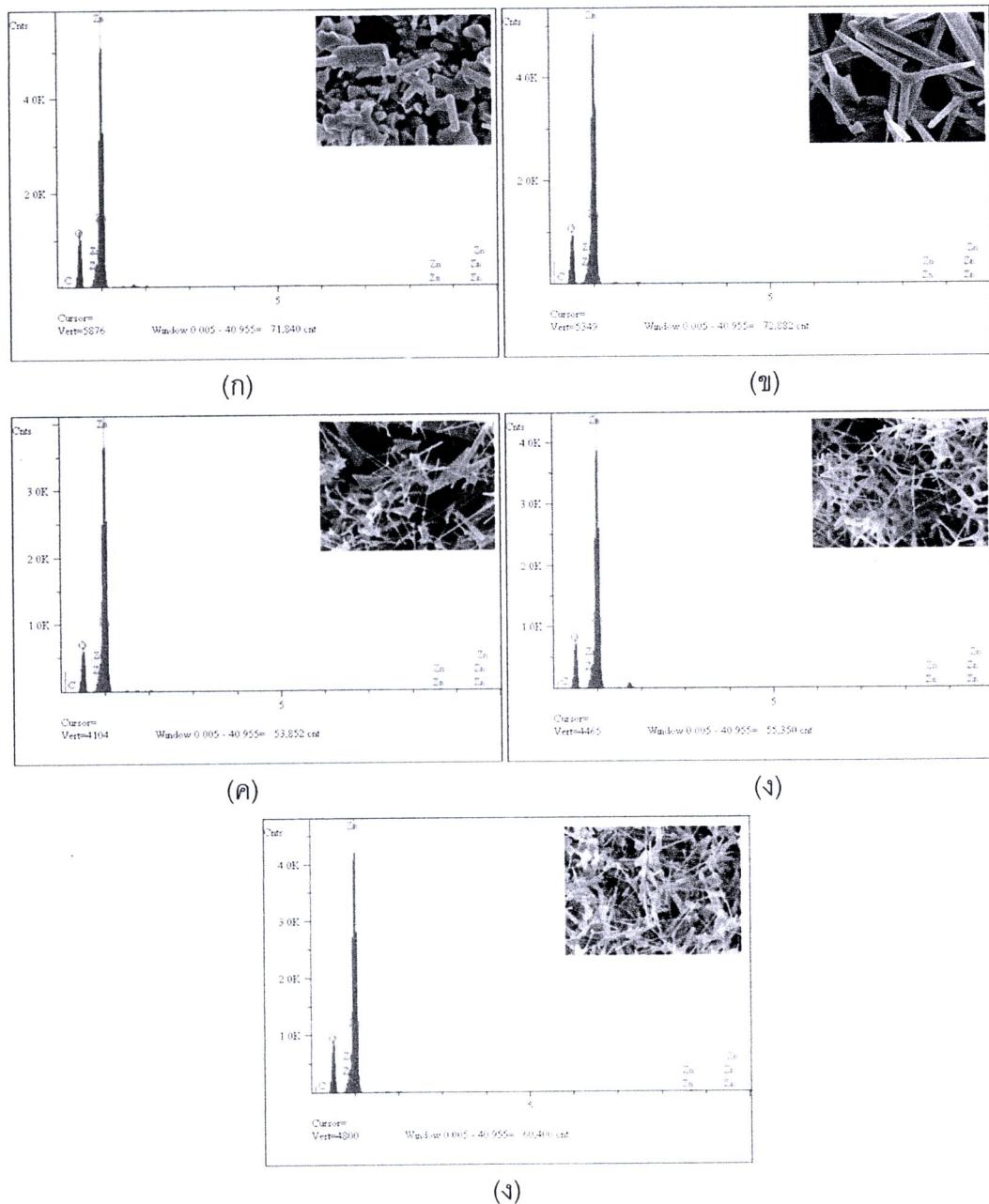
ผลการวัด EDX ของชิ้นงานหั้ง 5 มีปริมาณสัดส่วนอะตอมของธาตุ Zn และ O ดังแสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 : ปริมาณธาตุที่ปรากฏบนชิ้นงานของการทดลองหั้ง 5 นี้อนໄก

รูปที่ 4.11	ก้าซปฏิกิริยา	Zn (%)	O (%)	Zn:O
(ก)	ออกซิเจน	43.20	56.80	1:1.31
(ข)	Air Zero	48.31	51.68	1:1.06
(ค)	Air Zero ผ่านน้ำอุณหภูมิ $35^\circ\text{C}$	53.82	46.18	1.16:1
(ง)	Air Zero ผ่านน้ำอุณหภูมิ $45^\circ\text{C}$	43.56	56.43	1:1.3
(จ)	Air Zero ผ่านน้ำอุณหภูมิ $55^\circ\text{C}$	44.45	55.55	1:1.24



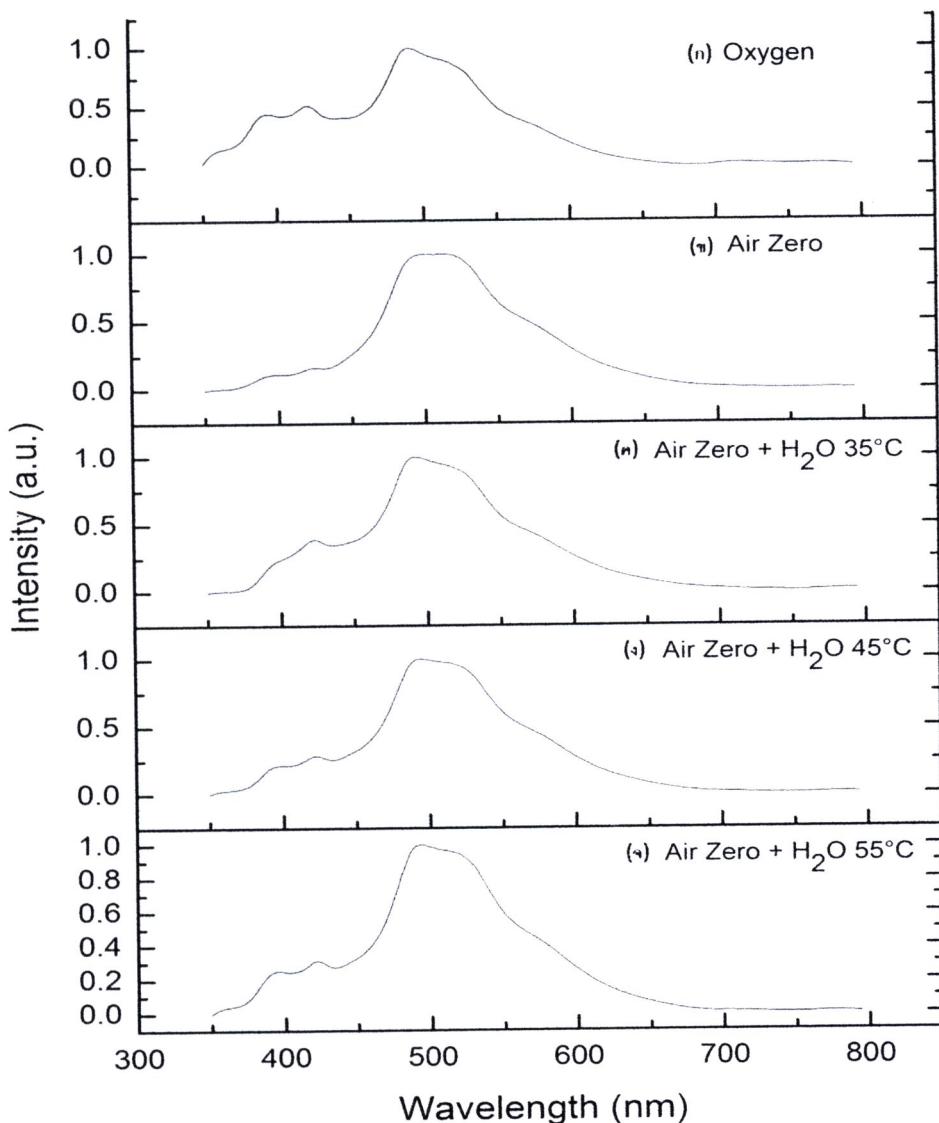
รูปที่ 4.10: สเปกตรัมการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของชิ้นงานที่เกิดจากก้าซปฏิกิริยา (ก) ออกซิเจน, (ข) Air Zero, Air Zero ผ่านน้ำอุณหภูมิ (ค) 35°C, (ล) 45°C และ (จ) 55°C



รูปที่ 4.11: สเปกตรัมองค์ประกอบทางเคมี (รูปหลัก) และภาพ SEM ขนาดขยาย 20,000 เท่า (รูปแทรก) ของชิ้นงานที่เกิดจาก (ก) ออกซิเจน, (ข) Air Zero, Air Zero ผ่านน้ำอุณหภูมิ (ค)  $35^{\circ}\text{C}$ , (ง)  $45^{\circ}\text{C}$  และ (จ)  $55^{\circ}\text{C}$

#### 4.3.3 ผลการตรวจวัดสมบัติทางแสงโดยเทคนิค PL

ผลการตรวจวัดสมบัติทางแสงโดยเทคนิค PL ของชิ้นงานหั้ง 5 ถูกแสดงในรูปที่ 4.12 (ก)-(จ) โดยชิ้นงานหั้ง 5 ต่างมีค่าよどในช่วงความยาวคลื่นดีயวกันดังนี้ 1) แสงม่วงน้ำเงินที่ความยาวคลื่น 390 nm, 2) แสงสีน้ำเงินที่ความยาวคลื่น 420 nm และ 3) แสงสีเขียวช่วงกว้างที่ความยาวคลื่น 490-530 nm



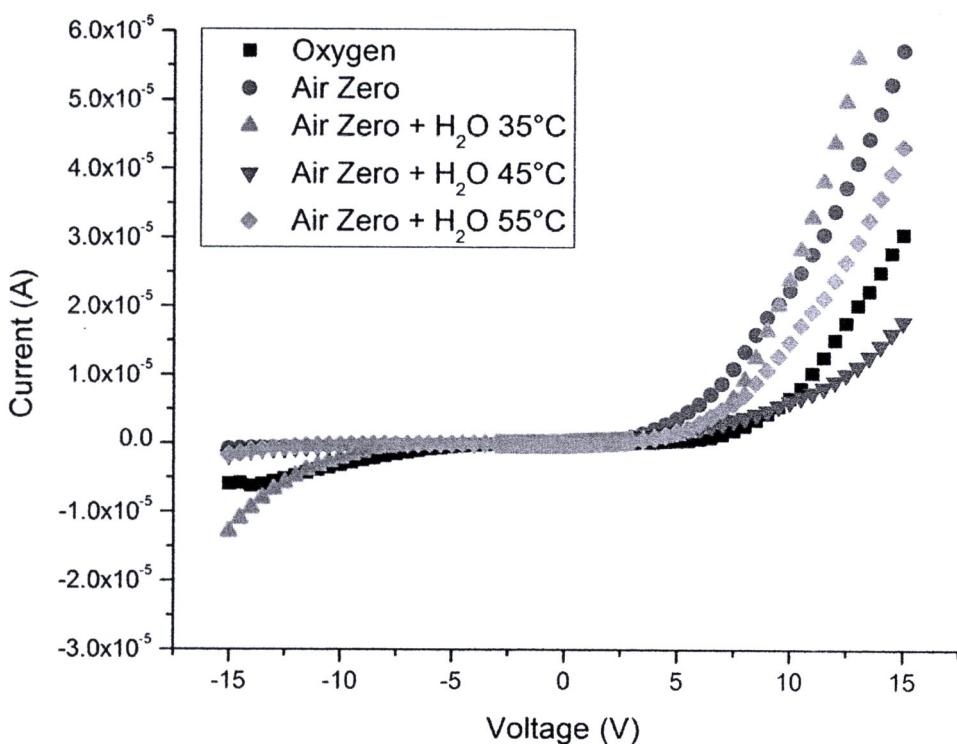
รูปที่ 4.12: สเปกตรัมการเปล่งแสงของชิ้นงานที่เกิดจากก้าชปฏิกิริยา (ก) ออกซิเจน, (ข) Air Zero, Air Zero ผ่านน้ำอุณหภูมิ (ค) 35°C, (ง) 45°C และ (จ) 55°C

แสงที่ตรวจวัดได้ ณ ความยาวคลื่นช่วง 390 nm (3.17 eV) เกิดจากการเปล่งแสงจาก ระดับพลังงานที่อยู่ใกล้กับค่าซึ่งว่างແเกบพลังงานหรือเกิดจาก exciton ซึ่งพบได้ในโครงสร้าง เนื่องจากมีพลังงานยึดเหนี่ยว (60 meV) สูงกว่าที่อุณหภูมิห้อง (26 meV) [39,63,71,73] แสงที่ตรวจวัดได้ในช่วงความยาวคลื่น 420 nm (2.95 eV) สามารถอธิบายได้จากแบบจำลองของ Sun [38] รูปที่ 2.9 หัวข้อ 2.2 เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากระดับพลังงาน ของ  $Zn^{+}$  สู่ແเกบเวเลนซ์ กล่าวไว้ว่าปริมาณของ  $Zn^{+}$  มีค่าสูงเมื่อ Zn เกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนปริมาณมาก (ก๊าซปฏิกิริยา ออกซิเจน) ส่งผลให้เกิดค่ายอดสูงที่ความยาวคลื่น 420 nm จนกระทั่งลดปริมาณออกซิเจนลง (ก๊าซปฏิกิริยา Air Zero) ค่ายอดที่ 420 nm ก็ลดลงเช่นกัน จากนั้นค่ายอดที่ 420 nm จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อปริมาณของออกซิเจนสูงขึ้นเนื่องจากความชื้นที่ใสเข้าไปคือก๊าซปฏิกิริยา Air Zero ผ่านน้ำที่อุณหภูมิ 35, 45 และ 55°C ตามลำดับ

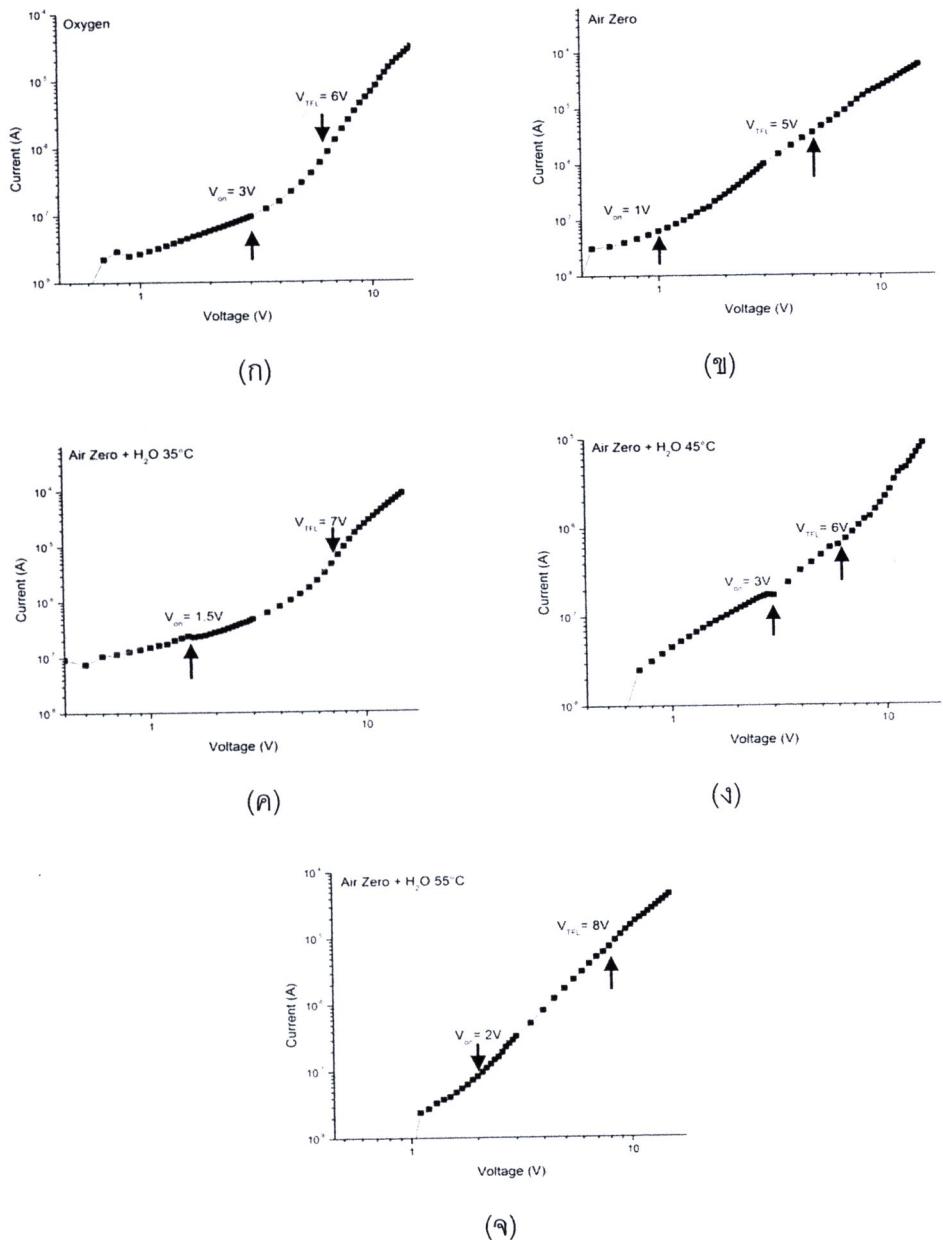
การเปล่งแสงสีเขียวช่วงกว้างที่ความยาวคลื่น 490-530 nm (2.47-2.37 eV) สามารถอธิบายได้โดยการเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานที่เกิดจากจุดบกพร่องของโครงผลึกดังนี้ 1) จากແກบการนำไปสูตรดับพลังงาน  $O^{+}$  (2.47 eV หรือ 490 nm) หรือ  $O_{Zn}$  (2.37 eV หรือ 530nm) และ 2) ระดับพลังงานที่เกิดจาก  $V_{OZn}^{+}$  ไปสู่ແเกบเวเลนซ์ (2.4 eV หรือ 516 nm) จากเงื่อนไขการทดลองสามารถพิจารณาได้ว่า เมื่อใช้ก๊าซปฏิกิริยาที่มีปริมาณออกซิเจนสูงคือก๊าซปฏิกิริยาออกซิเจน ส่งผลให้เกิด  $O^{+}$  ค่ายอดที่ความยาวคลื่นที่ 490 nm จึงปรากฏขึ้น จากนั้นเมื่อลดปริมาณออกซิเจนเป็นก๊าซปฏิกิริยา Air Zero ค่ายอดที่ความยาวคลื่น 490 nm จึงลดลง จนกระทั่งเพิ่มปริมาณของออกซิเจนด้วยก๊าซปฏิกิริยา Air Zero ผ่านน้ำที่อุณหภูมิ 35, 45 และ 55°C ค่ายอดที่ความยาวคลื่น 490 nm จะค่อยๆ ปรากฏขึ้นเด่นชัดอีกครั้ง ในส่วนของค่ายอดที่ความยาวคลื่น 530 nm ที่เกิดจาก  $O_{Zn}$  สามารถสังเกตได้ในทุกเงื่อนไขของการทดลองซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความไม่เป็นระเบียบในการจัดเรียงอะตอมของโครงสร้าง nano ใน  $ZnO$  ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลอง [65,70,74-77] ที่กล่าวถึงการออกซิเดชันในบรรยายกาศที่มีออกซิเจนปริมาณสูงส่งผลให้เกิดความไม่เป็นระเบียบในโครงผลึกปรากฏเป็นค่าอดีตช่วงความยาวคลื่นแสงสีเขียว

#### 4.3.4 ผลการตรวจวัดลักษณะสมบติกระแส-แรงดัน

ลักษณะสมบติกระแส-แรงดันของชิ้นงานทั้ง 5 ที่อุณหภูมิห้องภายในได้บรรยายกาศ 1 atm ถูกแสดงในรูปที่ 4.13 กระแสในช่วงแรกจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นกับแรงดัน  $V_{on-measure}$  คือค่า  $V_{on}$  ที่ได้จาก การทดลองนี้ซึ่งมีค่า  $\approx 1\text{-}3$  V และกระแสจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นที่  $V_{TFL-measure}$  คือค่าที่  $V_{TFL}$  ได้จากการทดลองนี้มีค่า  $\approx 5\text{-}8$  V อัตราการเพิ่มขึ้นของกระแสจะแปรผันตาม  $V^2$  โดยแรงดัน  $V_{on-measure}$  และ  $V_{TFL-measure}$  ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 3.2.5 ในการกำหนดค่ากราฟกระแส-แรงดันจากรูปที่ 4.13 ได้ถูกวดใหม่โดยแสดงแบบ log-log ดังรูปที่ 4.14



รูปที่ 4.13: กราฟลักษณะสมบติกระแส-แรงดันของชิ้นงานที่เกิดจากกําชปฎิกิริยาออกซิเจน (■), Air Zero (●), Air Zero ผ่านน้ำอุณหภูมิ 35°C (▲), 45°C (▽) และ 55°C (◇)



รูปที่ 4.14: กราฟลักษณะสมบัติกระแส-แรงดัน plot แบบ log-log ของชิ้นงานที่เกิดจากกําชีพกําริยา (ก) อออกซิเจน, (ຂ) Air Zero, Air Zero ผ่านน้ำอุณหภูมิ (ຄ)  $35^\circ C$ , (ຈ)  $45^\circ C$  และ (ຊ)  $55^\circ C$

ตารางที่ 4.3: ผลของก้าซปภิกรณ์ที่มีต่อ  $V_{TFL-measure}$

ก้าซปภิกรณ์	$V_{TFL-measure}$ (V)
ออกซิเจน	6
Air Zero	5
Air Zero ผ่านน้ำอุณหภูมิ 35°C	7
Air Zero ผ่านน้ำอุณหภูมิ 45°C	6
Air Zero ผ่านน้ำอุณหภูมิ 55°C	8

ค่าที่ได้จากการกระแส - แรงดันในรูปที่ 4.13 จากการไปแอสไปร์ชั่นหน้าและย้อนกลับ ไม่สมมาตรกัน เนื่องจากความไม่สมมาตรของโครงสร้างนาโน ZnO, การเชื่อมต่อ (coupling) ระหว่างแผ่นฐานและ ZnO ที่ต่างกันทั้ง 2 ด้าน, เกิดจาก charging effects ซึ่งส่งผลให้การนำไปฟื้นฟูทั้งสองทิศทางแตกต่างกัน [78-79]

ค่า  $V_{TFL-measure}$  ที่เกิดจากก้าซปภิกรณ์ต่างๆ ถูกแสดงในตารางที่ 4.2 ค่า  $V_{TFL-measure}$  ที่สูง บ่งบอกถึง ปริมาณ ของระดับการดักจับอิเล็กตรอนแบบเดี่ยวภายในวัสดุ (single trap concentrations) ดังสมการ

$$V_{TFL-measure} = \frac{n_t q d^2}{2\epsilon\epsilon_0} \quad (3.1x)$$

พบว่าค่า  $V_{TFL-measure}$  ที่เกิดจากก้าซปภิกรณ์ Air Zero ผ่านน้ำอุณหภูมิ 55°C, Air Zero ผ่านน้ำอุณหภูมิ 45°C, ก้าซออกซิเจน และ Air Zero ผ่านน้ำอุณหภูมิ 35°C, Air Zero มีค่า 8, 7, 6 และ 5 ตามลำดับ หากพิจารณาว่า  $V_{TFL-measure}$  แปรผันตามความเข้มข้นของกับดักพำนัช (trap concentration) เพียงอย่างเดียวพบว่าค่า  $V_{TFL-measure}$  มากส่งผลให้ค่า  $n_t$  มีปริมาณมาก ค่า  $V_{TFL-measure}$  จากการทดลองเงื่อนไขต่างๆ แตกต่างไปจากผลการทดลองของ [42-43] ซึ่งมีค่าประมาณ 1 V อาจเกิดได้จาก 1) ความไม่สม่ำเสมอของพิล์ม ในแต่ละตำแหน่ง, 2) ความหนาของพิล์ม (d) ที่อยู่บนแผ่นฐานในแต่ละการทดลอง นั้นไม่เท่ากัน, 3) ความต้านทานของ Si ที่นำมาใช้ประกอบกับ ZnO อีกข้างหนึ่ง ส่งผลให้เกิดความต่างศักย์ต่อกันสูง ค่า  $V_{TFL-measure} \approx V_{TFL} + 2V_{Si}$  ที่ได้จะสูงกว่าความเป็นจริงเนื่องจากมีผลของความต้านทานของ Si

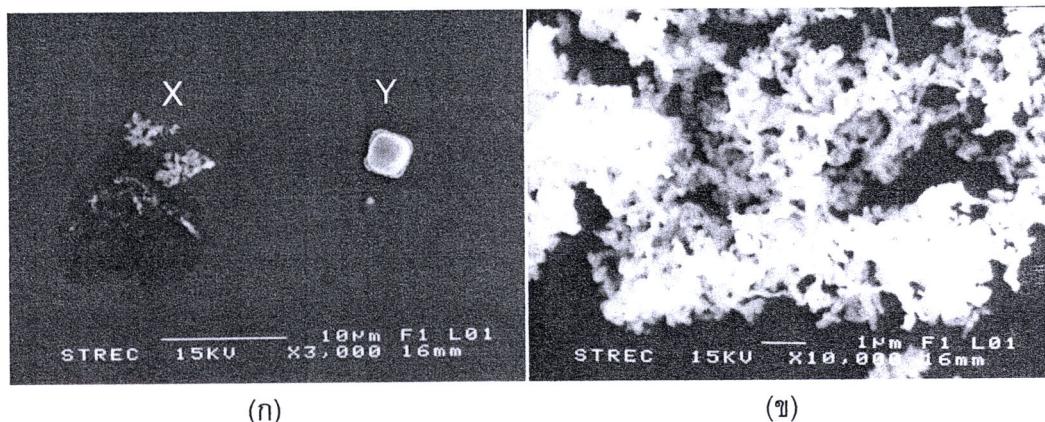
การคำนวณด้วยทฤษฎีของ Mott-Gurney และ Lampert-Mark นั้นเป็นการประมาณในเบื้องต้นสำหรับการนาปริมาณกับดักชนิดเดียว แต่ในความเป็นจริงกับดักภายในชั้นงานสามารถเกิดได้จากการระดับพลังงาน หลายระดับ ซึ่งการคำนวณจะต้องอาศัยคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อน [80-81]

#### 4.4 ผลกระทบจากสารตั้งต้นที่ถูกป่นเป็นอนุภาค UC

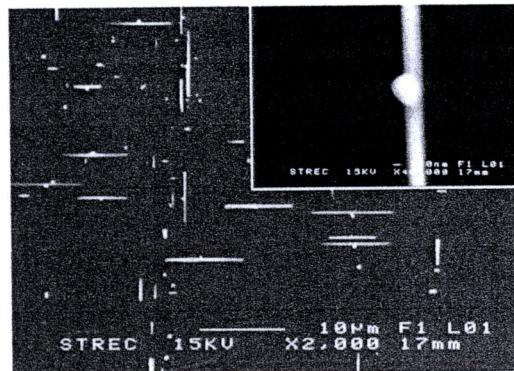
การป่นเป็นอนุภาคในระหว่างกระบวนการสังเคราะห์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายและเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการเนื่องจากทำให้คุณสมบัติของสิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การเตรียมโครงสร้าง nano ZnO ในหัวข้อนี้อัตราการไหลของก๊าซปฏิกิริยา Air Zero ผ่านน้ำที่อุณหภูมิ 37 และ 39°C ถูกควบคุมโดย mass flow controller ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ VbaLIEW ที่อัตราการไหล 500 sccm เป็นเวลา 15 วินาที

##### 4.4.1 ผลการตรวจวัดโครงสร้างโดยเทคนิค SEM

โครงสร้าง nano ZnO สามารถเก็บติดบนแผ่นฐานได้น้อยมากเมื่อควบคุมอัตราการไหลของก๊าซปฏิกิริยาด้วย mass flow controller ดังแสดงในรูปที่ 4.15 และ 4.16 โครงสร้างที่สังเกตได้มีลักษณะเส้นสาย (ตำแหน่ง X), โครงสร้างลักษณะสี่เหลี่ยม (ตำแหน่ง Y) ดังแสดงในรูปที่ 4.15(ก) และโครงสร้างคล้ายห่อขนาด 1-8  $\mu\text{m}$  ดังแสดงในรูปที่ 4.16 ซึ่งโครงสร้างสี่เหลี่ยมและห่อหงายไม่ค่อยพบเห็นใน ZnO จึงทำการตรวจสอบคงประสกของทางเคมี จากการทดลองทั้งสองเงื่อนไขได้ผลดังนี้

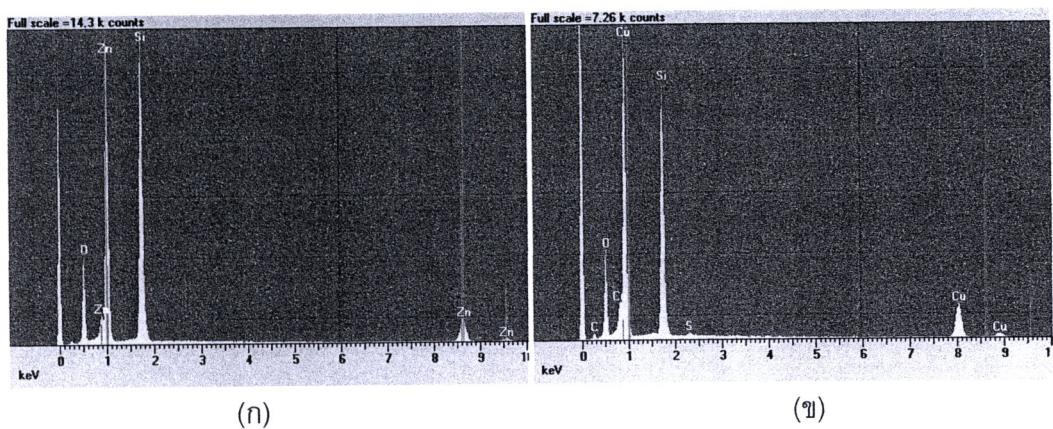


รูปที่ 4.15: ภาพ SEM ของ ZnO ที่เกิดจากก๊าซปฏิกิริยา Air Zero ผ่านน้ำอุณหภูมิ 37°C ขนาดขยาย (ก) 3,000 เท่า และ ภาพขยายสำหรับตำแหน่ง X (ข) 10,000 เท่า

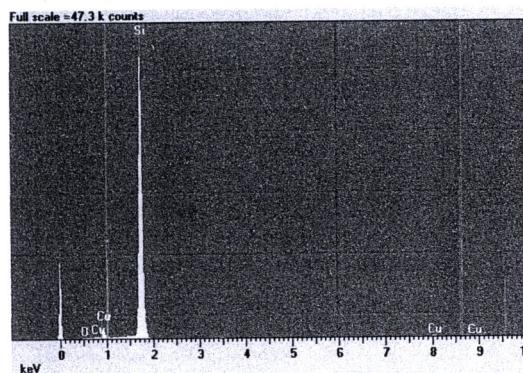


รูปที่ 4.16: ภาพ SEM ขนาดขยาย 2,000 เท่า (รูปในญี่ปุ่น) และ 40,000 เท่า (รูปขยาย) ของ ZnO ที่เกิดจากก๊าซปฏิกิริยา Air Zero ผ่านน้ำอุณหภูมิ 39°C

#### 4.4.2 ผลการตรวจวัดโครงสร้างโดยเทคนิค EDX



รูปที่ 4.17: สเปกตรัมองค์ประกอบทางเคมีของ ZnO ที่เกิดจากก๊าซปฏิกิริยา Air Zero ผ่านน้ำอุณหภูมิ 37°C ที่ตำแหน่ง (η) X และ (υ) Y



รูปที่ 4.18: สเปกตรัมองค์ประกอบทางเคมีของ ZnO ที่เกิดจากก๊าซปฏิกิริยา Air Zero ผ่านน้ำอุณหภูมิ 39°C ที่มีโครงสร้างลักษณะคล้ายท่อ

ผลการวัดสเปกตรัม EDX ของชิ้นงานที่เกิดจาก ก้าซป์วิเกอริยา Air Zero ผ่านน้ำอุณหภูมิ 37°C ที่มีโครงสร้างลักษณะเส้นสาย (ตำแหน่ง X) และสี่เหลี่ยม (ตำแหน่ง Y) ถูกแสดงในรูปที่ 4.17(g) และ 4.17(x) ตามลำดับ และผลการวัดสเปกตรัม EDX ของชิ้นงานที่เกิดจาก ก้าซป์วิเกอริยา Air Zero ผ่านน้ำอุณหภูมิ 39°C ที่มีโครงสร้างลักษณะคล้ายท่อถูกแสดงในรูปที่ 4.18

องค์ประกอบทางเคมีที่สังเกตได้จากโครงสร้างลักษณะเส้นสายยืนยันว่าเป็นโครงสร้าง ZnO ด้วยค่าอยอดของ Si ซึ่งมาจากการแผ่นฐาน, Zn และ O ตามลำดับ, โครงสร้างลักษณะสี่เหลี่ยม และท่อถูกยืนยันว่าเป็นโครงสร้าง CuO ด้วยค่าอยอดของ Si, Cu, O และ C ตามลำดับ ซึ่งการจัดเรียงท่อทองแดงใน 2 ทิศทางเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด และต้นตอของการเกิดยังไม่มีการรายงานมาก่อน

การปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการสังเคราะห์เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการเนื่องจากทำให้สิ่งประดิษฐ์ที่ได้มีคุณสมบัติเปลี่ยนไปกระบวนการตรวจสอบจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อกำจัดการปนเปื้อนออกไป จากสเปกตรัมองค์ประกอบทางเคมีพบว่าสามารถพบรูป วิมาณ Cu และ C ควบคู่กันจึงทำการสอบถามถึง กระบวนการผลิต CNTs พบรูปว่า CNTs ได้ถูกสังเคราะห์ขึ้นด้วยวิธีการเดียวกับงานวิจัยของ [17] แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือเป้าหมายที่ใช้ในการสังเคราะห์ซึ่งในที่นี้ทำมาจากทองแดงเป็นไปได้ว่าในกระบวนการสังเคราะห์ CNTs อาจมีทองแดงปนเปื้อนมาจากเบ้าหลอม